

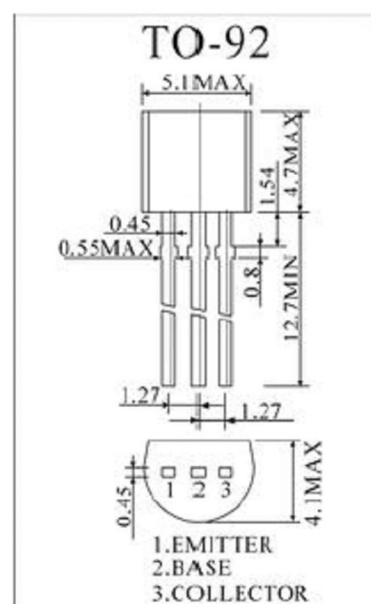
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

9013

—NPN silicon—

绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V _{CBO}	40	V
集电极—发射极电压	V _{CEO}	20	V
发射极—基极电压	V _{EB0}	5	V
集电极电流	I _c	500	mA
集电极耗散功率	P _c	600	mW
结 温	T _j	150	°C
存储温度	T _{stg}	- 55~150	°C



电参数 (Ta=25°C)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	64		300		V _{CE} =1 V, I _c =50 mA
集电极-基极截止电流	I _{CBO}			0.1	μ A	V _{CB} =25 V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EB0}			0.1	μ A	V _{EB} =3 V, I _c =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	40			V	I _c =0.1 mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	20			V	I _c =1 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	5			V	I _E =0.1mA, I _c =0
基极-发射极电压	V _{BE(ON)}	0.6	0.67	0.7	V	V _{CE} =1 V, I _c =10mA
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}		0.16	0.6	V	I _c =500 mA, I _B =50 mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}		0.91	1.2	dB	I _c =500 mA, I _B =50 mA

h_{FE} 分档及其标志

分 档	D	E	F	G	H	I
h _{FE}	64~91	78~112	96~135	112~166	144~202	200~300